

2SB1015

シリコンPNP三重拡散形

(2SB1015)

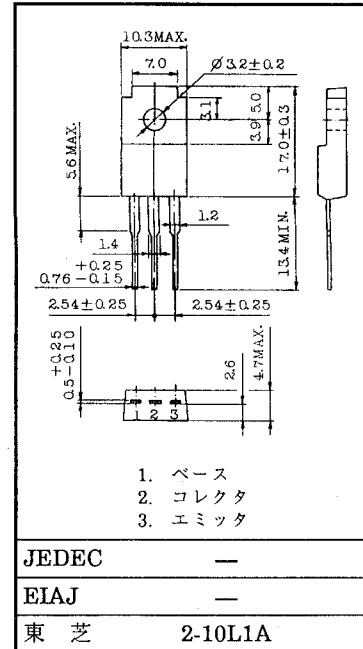
○ 低周波電力増幅用

単位 : mm

- 飽和電圧が低い。
: $V_{CE(sat)} = -1.7V$ (最大) ($I_C = -3A, I_B = -0.3A$)
- コレクタ損失が大きい。 : $P_C = 25W$ ($T_c = 25^\circ C$)
- 2SD1406とコンプリメンタリになります。

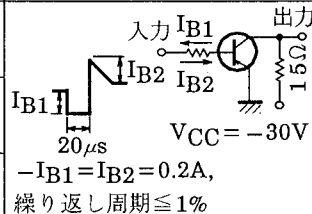
最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-60	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-60	V	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-7	V	
コレクタ電流	I_C	-3	A	
ベース電流	I_B	-0.5	A	
コレクタ損失	P_C	$T_a = 25^\circ C$	2.0	W
		$T_c = 25^\circ C$	25	
接合温度	T_j	150	$^\circ C$	
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$	



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$	—	—	-100	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -7V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-60	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	60	—	200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -3A$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.3A$	—	-0.5	-1.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5A, I_C = -0.5A$	—	-0.7	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	9	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0,$ $f = 1MHz$	—	150	—	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	—	0.4	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}	—	1.7	—	
	下降時間	t_f	—	0.5	—	



注 : $h_{FE(1)}$ 分類 O : 60~120, Y : 100~200